(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[4]
G11C 17/00

(11) 공개번호 특1991-0001774
(43) 공개일자 1991년01월31일

(21) 출원번호 특1989-0008067
(22) 출원일자 1989년06월10일

(71) 출원인 삼성전자 주식회사 김광호
경기도 수원시 권선구 매탄동 416번지
(72) 발명자 민동선
서울특별시 강남구 대치2동 은마아파트 3동 801호
(74) 대리인 조용식

심사청구 : 있음

(54) 반도체 집적소자의 내부전압 변환회로

요약

내용 없음

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

반도체 집적소자에 내부전압 변환회로

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명에 따른 반도체 집적소자의 내부 전압 변환회로를 나타낸 실시회로도,

제4도는 본 발명에 따른 바이어스회로의 구체적인 실시회로도,

제5도는 본 발명에 따른 동작상태를 나타낸 타임챠트.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

[발명의 상세한 설명]

내용 없음

(57) 청구의 범위

청구항 1

반도체 소자내에 내부전압 변환회로를 가지는 다음과 같은 구성; 구형파의 발진출력을 발생시키는 발진기(1)와, 상기 발진기(1)의 클럭을 입력으로하고 발전기의 발진출력을 챠아지 펌프(3)에 인가시키는 버퍼(2)와, 상기 드라이버(2)의 출력을 입력으로하여 피라미터 여진된 출력을 발생시키는 챠아지 펌프(3)와, 상기 챠아지 펌프(3)의 신호를 받아 내부 전원전압 레벨로 조절하여 기판전원(VOUT)으로 출력시키는 파워부(4)와, 로 구성된 서브회로(10)에 있어서, 공통으로 사용되는 하나의 상기한 발진기(1)와, 게이트 제어되는 버퍼(2')와, 상기 서브회로(10)와 동일한 구성을 가지는 챠아지펌프(3') 및 파워부(4')와, 내부전원 전압을 감지하여 상기 버퍼(2')의 구동을 제어하는 검출부(5)와, 로 구성되는 메인회로(20)와; 상기 메인회로(20)와 동일한 메인회로들이 상기 서브회로(10)에 병렬로 다단 연결되게 구성시킨 반도체 직접소자의 내부전압 변환회로.

청구항 2

제1항에 있어서, 공통으로 사용되는 하나의 발진기와 다수개의 분리된 버퍼회로, 챠아지 펌프, 파워부와로 구성된 내부전원 변환회로의 출력과 반도체 소자의 내부 발생클럭을 게이팅하여 신호 처리하는 논리수단과, 상기 논리수단에 의하여 제어받는 버퍼(2') 및 상기 논리수단에 의하여 제어받지 아니하는 버퍼(2)와, 상기 버퍼(2)(2')의 출력 클럭이 180。위상을 갖게하는 수단과, 로 되는 반도체 직접 소자의 내부전압 변환회로.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 버퍼(2)(2')에 구형파 펄스를 공급하는 발전기(1)가 버퍼회로의 갯수만큼 구성하며 각각의 발진기와 버퍼회로가 따로 동작되게 구성시킨 반도체 직접소자의 내부전압 변환회로.

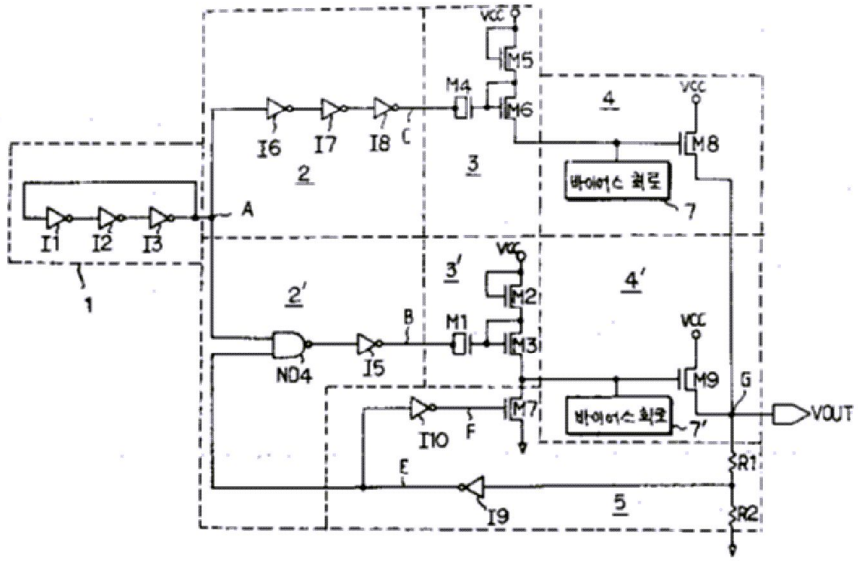
청구항 4

제2항에 있어서, 상기 버퍼(2)(2')에 구형파 펄스를 공급하는 발진기(1)가 버퍼회로의 갯수만큼 구성하며 각각의 발진기와 버퍼회로가 따로 동작되게 구성시킨 반도체 직접소자의 내부 전압 변화회로.

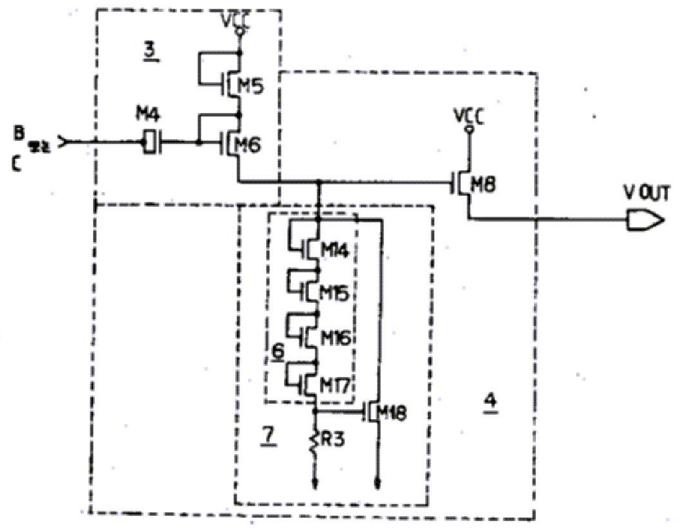
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

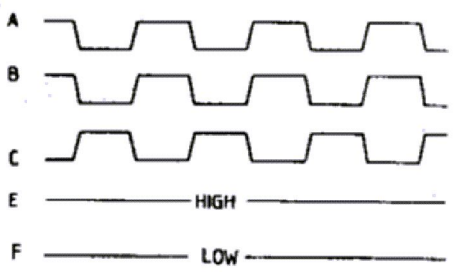
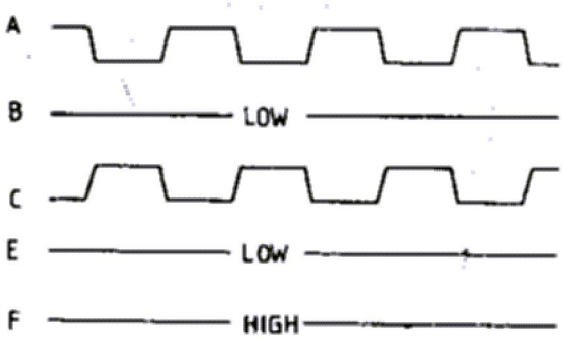
도면3



도면4



도면5(가)



도면5(나)